

InGaAs фотодетекторный чип 1740 нм, 200 мкм — техническое описание

P/N : WIR3-01B

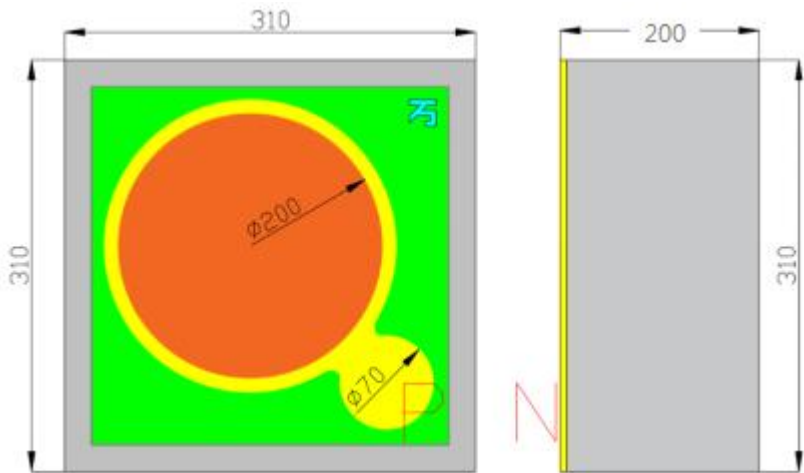
Особенности

Высокая чувствительность; низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–1740 нм

Структура

InGaAs/InP PIN-чип. Р-электрод (анод): золото.

N-электрод (катод): золото.



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область		200		мкм
Ширина чипа		310		мкм
Длина чипа		310		мкм
Высота чипа	180	200	220	мкм
Размер контактной площадки		70		мкм

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Темновой ток	Id	-10V		0.3	1	нА
Чувствительность	R	@1653 nm	0.9	0.95		А/Вт
Емкость	Cp	f=1MHz,Vr=-3V		3	5	пФ
Рабочий диапазон длин волн	λ	-	900	1650	1740	нм

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Рабочая температура	от -40 °C до +85 °C
Температура хранения	от -55 °C до +125 °C
Прямой ток	10 мА